

Les alimentations à découpage...



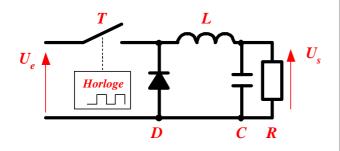
III.1) Classification des alimentations à découpage.





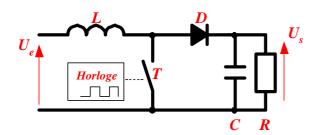
Non isolées de la source

Convertisseur abaisseur « BUCK »



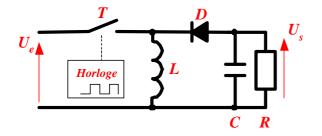
$$V_s = a V_e a vec a < 1$$

Convertisseur élévateur « BOOST »



$$V_s = \frac{1}{1 - a} V_e \ avec V_s > V_e$$

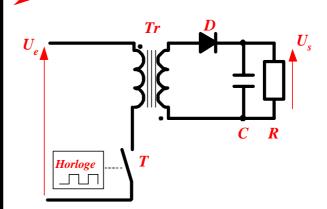
Convertisseur inverseur « BUCK BOOST »



$$V_{s} = -\frac{\mathbf{a}}{1 - \mathbf{a}} V_{e} avec V_{s} < 0$$

Isolées de la source

Convertisseur flyback

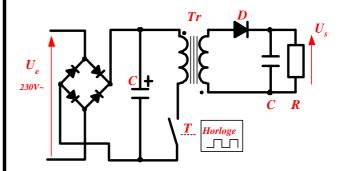


Ce convertisseur est très utilisé dans les alimentations. Il permet de s'affranchir de transformateurs volumineux. La tension aux bornes d'un enroulement est fonction de la fréquence (Us = 4.44 * B*N*S*f). Pour une même valeur de tension si f augmente alors N diminue et par conséquent le volume du transformateur.

Pour une alimentation classique : f=50Hz

Pour une alimentation à découpage : f > 20 Khz.

Schéma typique d'une alimentation.



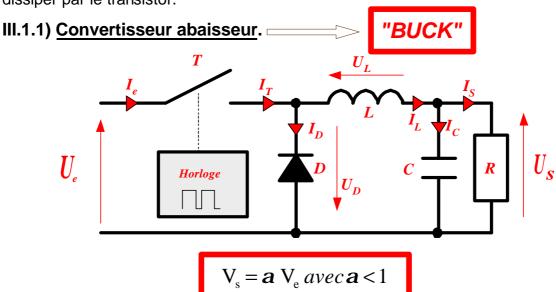
Remarque: On redresse directement le secteur, par conséquent le pont diodes et le condensateur de filtrage devront être correctement dimensionnés pour supporter ce secteur.





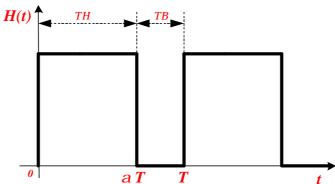
III.1) Les alimentations non isolées de la source: (avec une bobine).

Elles permettent d'abaisser, élever et inverser une tension continue avec de très faibles pertes. Par conséquent ils ont un très bon rendement, peu d'énergie à dissiper par le transistor.



III.1.1.1) Principe de fonctionnement :

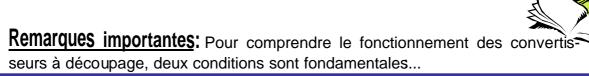
Le transistor T est commandé par une horloge H. Pendant le temps haut de l'horloge (PHASE N°1 de 0 à a T), le transistor T est commandé et la bobine L emmagasine de l'énergie, puis pendant le temps bas de l'horloge (PHASE N°2 de a T à T), le transistor est bloqué et la bobine L restitue l'énergie emmagasinée.



Le rapport cyclique
$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{TH}}{\mathrm{T}} = \frac{\mathbf{a} T}{T}$$





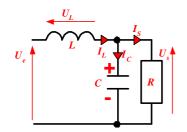


- 1) La valeur moyenne de la tension aux bornes d'une bobine est nulle.
- 2) La tension de sortie est continue.

Phase N°1 (0 à a T)

Explications: Le transistor est passant et la diode **D** est bloquée.

Schéma équivalent :

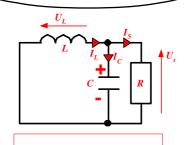


$$U_L = U_E - U_S avec U_E > U_S$$

Phase N°2 (a T à T)

Explications: Le transistor est bloqué et c'est la bobine qui fournit l'énergie au montage, la diode D est passante.

Schéma équivalent :

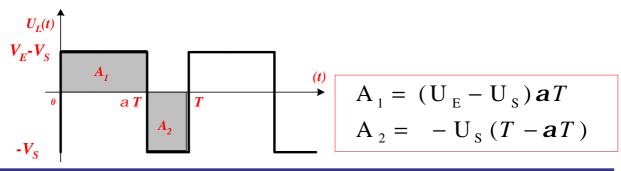


$$U_L = -U_S$$

III.1.1.2) Calcul de la fonction de transfert :



$$U_{\rm S} = f(U_{\rm E})$$



La valeur moyenne de la tension aux bornes d'une bobine est toujours nulle :

$$\langle \mathbf{U}_{L} \rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{L}(t) dt = \frac{1}{T} [A_{1} + A_{2}] = 0$$

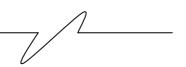
$$(\mathbf{U}_{E} - \mathbf{U}_{S}) \mathbf{a} - \mathbf{U}_{S} (1 - \mathbf{a}) = 0$$

$$\mathbf{a} \mathbf{U}_{E} - \mathbf{a} \mathbf{V}_{S} - \mathbf{U}_{S} + \mathbf{a} \mathbf{V}_{S} = 0$$

$$U_s = a U_E$$









III.1.1.3) Etude des signaux:

Phase N°1 (0 à a T)

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine augmente.

$$L\frac{di_{L}}{dt} = U_{E} - U_{S}$$

$$I_{L}(t) = \frac{U_{E} - U_{S}}{L}t + I_{min}$$

2) ID : Courant dans la diode

La diode est bloquée : $I_D(t) = 0$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est passant : $I_T(t) = I_L(t)$

Phase N°2 (a T à T

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine diminue.

$$L\frac{di_{L}}{dt} = -U_{S}$$

$$I_{L}(t) = \frac{-U_{S}}{L}t + I_{max}$$

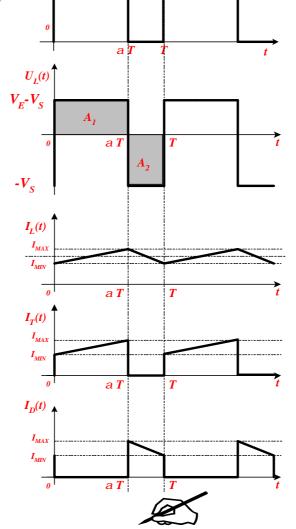
2) ID : Courant dans la diode

La diode est passante : $I_D(t) = I_L(t)$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est bloqué $I_T(t) = 0$

Les Chronogrammes:







III.1.1.4) Choix des composants

III.1.1.4.1) Choix de la bobine.

Son calcul:

Le calcul de la valeur de la self passe par l'ondulation crête à crête du courant de celle-ci, soit $\Delta I_{\rm I}$.

$$\Delta I_{L} = I_{M} - I_{m} = \frac{V_{E} - V_{s}}{L} a T$$
 $\Delta I_{L} = \frac{(1 - a)V_{s}}{LF}$

Soit:
$$L = \frac{(1-a)V_s}{\Delta I_L F}$$

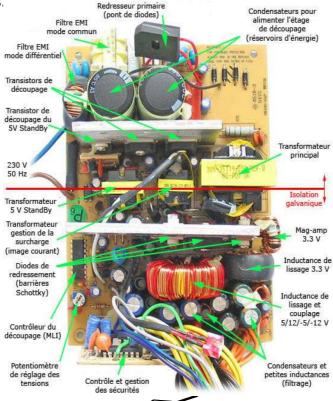
Nota:

DI_L Ondulation crête à crête du courant dans la bobine.

F: Fréquence de travail du convertisseur.

<u>Critères technologiques :</u>

Les selfs utilisées dans les alimentations à découpage doivent en autre supporter les hautes fréquences (jusqu'à 100KHz). Il faut toujours choisir les modèles préconisés par les constructeurs.



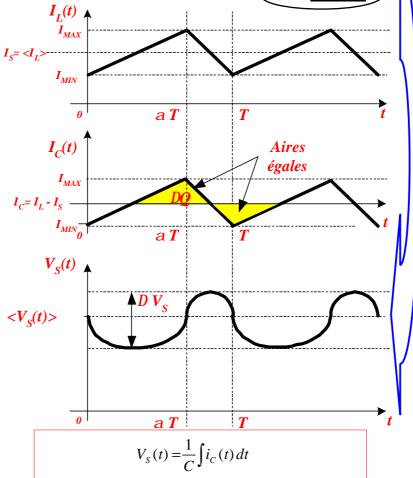




III.1.1.4.2) Choix du condensateur.

Son calcul:

Depuis le début de cet exposé, j'ai considéré que la tension V_s était continue, mais en réalité une petite variation $v_s(t)$ subsiste.



$$V_{S}(t) = \frac{1}{C} \int i_{C}(t) dt$$

$$\Delta V_{S} = \frac{\Delta Q}{C} \quad et \quad \Delta Q = \frac{1}{2} \frac{\Delta_{IL}}{2} \frac{T}{2} \quad donc \ \Delta V_{S} = \frac{\Delta I_{L}}{8CF}$$

$$et \ \Delta I_{L} = \frac{(1-\mathbf{a})V_{S}}{LF} \quad donc \ \Delta V_{S} = \frac{(1-\mathbf{a})V_{S}}{8LCF^{2}}$$

Soit:

$$=\frac{(1-\boldsymbol{a})V_{s}}{8LF^{2}\Delta V_{s}}$$

 $\overline{DV_S}$ Ondulation crête à crête de la tension de sortie.

Critères technologiques:

Les condensateurs utilisés dans les alimentations à découpage doivent avoir une faible résistance série (ESR Effective Serie Resistor). En effet l'ondulation de la tension de sortie est proportionnelle aux variations de courant du condensateur.







III.1.1.4.3) Choix de la diode et du transistor T

Le principal critère de choix de la diode doit être la rapidité, en effet les convertisseurs à découpage fonctionnent à des fréquences de l'ordre de la dizaine de kilohertz. On choisit par conséquent des diodes rapides comme les diodes *schottky*. Pour le transistor, il doit posséder une faible résistance et commuter rapidement, on utilise souvent des transistors *MOS*.

III.1.1.5) Performances.

Rendement: Si on considère des composants parfaits ($V_{SAT}=0V$ et $V_{seuil}=0V$) le rendement est de 100%, c'est-à-dire que l'on ne perd pas d'énergie!

En réalité la diode a une tension de seuil V_D et le transistor une tension V_{SAT} à ses bornes quand il conduit. On peut dans ces conditions calculer le rendement :

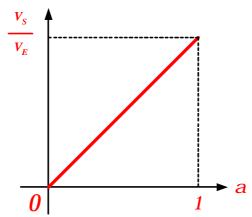


$$\boldsymbol{h} = \frac{V_S (V_E - V_{sat} + V_D)}{V_E (V_S + V_D)}$$



Avec cette équation on obtient des rendements de l'ordre de 80% à 90%, à comparer aux rendements des alimentations classiques de l'ordre de 50%.

Courbe de transfert.



Ondulations de sorties.



Ondulation du courant dans l'inductance :

$$\Delta I_L = \frac{(1-\mathbf{a})\mathbf{a} \ V_E}{LF}$$



Ondulation de la tension de sortie (ESR = 0 W)

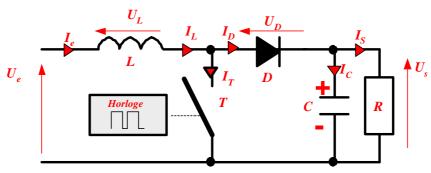
$$\Delta V_S = \frac{(1-\mathbf{a})\mathbf{a} \ V_E}{8LC F^2}$$





III.1.2) Convertisseur élévateur.





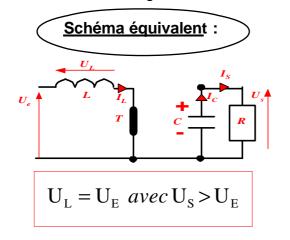
$$V_s = \frac{1}{1 - a} V_e avec V_s > V_e$$

III.1.2.1) Principe de fonctionnement :

Le transistor T est commandé par une horloge H. Pendant ce temps haut de l'horloge (PHASE N°1 de 0 à a T), le transistor T est commandé et la bobine L emmagasine de l'énergie et le condensateur C restitue son énergie à la charge. Pendant le temps bas de l'horloge (PHASE N°2 de a T à T), le transistor est bloqué et la bobine L restitue l'énergie emmagasinée, la diode est passante donc U_s est supérieure à U_e.

Phase N°1 (0 à a T)

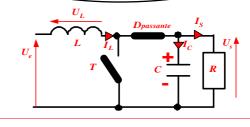
Explications: Le transistor est passant et la diode **D** est bloquée. Le condensateur restitue son énergie.



Phase N°2 (a T à T)

<u>Explications</u>: Le transistor est bloqué et c'est la bobine qui fournit l'énergie au montage, la diode **D** est passante.

Schéma équivalent :



$$U_S = U_E - U_L et U_L = L \frac{d I_L}{dt}$$

Comme le courant I_L diminue alors $U_L < 0$ en conséquence $U_S > U_E$

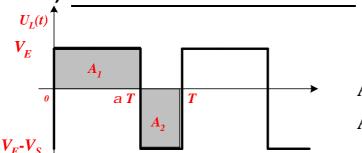




ELECTRONIQUE / ROBOTIQUE. LES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES.



III.1.2.2) Calcul de la fonction de transfert :



$$\mathbf{U}_{\mathrm{S}} = f(U_{\mathrm{E}})$$

$$A_1 = U_E aT$$

$$A_2 = (U_E - U_S) (T - aT)$$

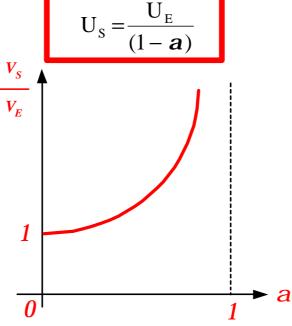
La valeur moyenne de la tension aux bornes d'une bobine est toujours nulle :

$$< U_{L} > = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{L}(t) dt = \frac{1}{T} [A_{1} + A_{2}] = 0$$

$$U_{E} \mathbf{a} + (U_{E} - U_{S})(1 - \mathbf{a}) = 0$$

$$\mathbf{a} V_{E} + U_{E} - U_{S} - \mathbf{a} U_{E} + \mathbf{a} U_{S} = 0$$

Courbe de transfert.



Les tensions élevées avec un rapport cyclique proche de 1 sont difficiles à atteindre à cause des imperfections des composants.



III.1.2.3) Etude des signaux:

Phase N°1 (0 à a T)

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine augmente.

$$L \frac{di_L}{dt} = U_E$$

$$I_L(t) = \frac{\mathbf{U}_{\mathrm{E}}}{L}t + I_{\min}$$

2) ID : Courant dans la diode

La diode est bloquée : $I_D(t) = 0$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est passant : $I_T(t) = I_L(t)$

Phase N°2 (a T à T)

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine diminue.

$$L\frac{di_{L}}{dt} = U_{E} - U_{S}$$

$$I_L(t) = -\frac{\mathbf{U}_{\mathrm{S}} - \mathbf{U}_{\mathrm{E}}}{L}t + I_{\mathrm{max}}$$

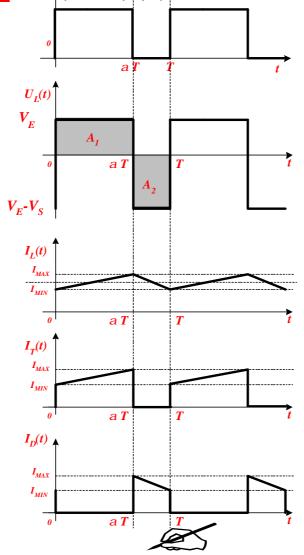
3) ID: Courant dans la diode

La diode est passante : $I_D(t) = I_L(t)$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est bloqué $I_T(t) = 0$

Les chronogrammes: H(t)





III.1.2.4) Choix des composants.

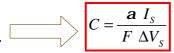
$$\int L = \frac{(1-a)aV_s}{\Delta I_L F}$$

 $m{F}$: Fréquence de travail du convertisseur, $m{D}m{I}_L$ Ondulation crête à crête du courant dans la bobine.

Critères technologiques .

Les selfs utilisées dans les alimentations à découpage doivent en autre supporter les hautes fréquences (jusqu'à 100KHz). Il faut toujours choisir les modèles préconisés par les constructeurs.

III.1.2.4.2) Le condensateur.



DV_S Ondulation crête à crête de la tension de sortie.

Critères technologiques :

Les condensateurs utilisés dans les alimentations à découpage doivent avoir une faible résistance série (ESR Effective Serie Resistor).

III.1.2.4.3) Choix de la diode et du transistor T.

Le principal critère de choix de la diode doit être la rapidité, en effet les convertisseurs à découpage fonctionnent à des fréquences de l'ordre de la dizaine de kilohertz. On choisit par conséquent des diodes rapides comme les diodes *schottky*. Pour le transistor, il doit posséder une faible résistance et commuter rapidement, on utilise souvent des transistors *MOS*.

III.1.2.5) <u>Performances</u>.

Rendement : Si on considère des composants parfaits ($V_{SAT}=0V$ et $V_{seuil}=0V$) le rendement est de 100%, c'est-à-dire que l'on ne perd pas d'énergie ! !

En réalité la diode a une tension de seuil V_D et le transistor une tension V_{SAT} à ses bornes quand il conduit. On peut dans ces conditions calculer le rendement :



$$\boldsymbol{h} = \frac{V_S (V_E - V_{sat})}{V_E (V_S + V_D - V_{sat})}$$



Avec cette équation on obtient des rendements de l'ordre de 80% à 90%, à comparer aux rendements des alimentations classiques de l'ordre de 50%.

Ondulations de sorties.



Ondulation du courant dans l'inductance : [



$$\Delta I_L = \frac{a V_E}{LF}$$



Ondulation de la tension de sortie (ESR = 0W): [



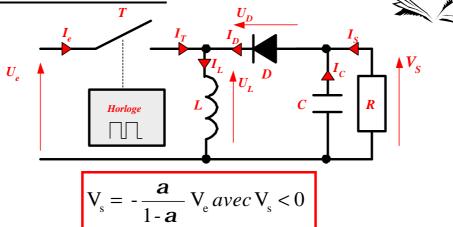
$$\Delta V_S = \frac{I_S \mathbf{a}}{C F}$$







III.1.3) Convertisseur inverseur « BUCK - BOOST ».

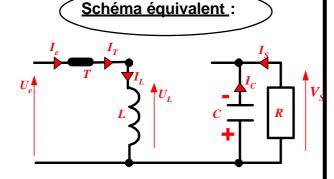


III.1.3.1) Principe de fonctionnement :

Le transistor T est commandé par une horloge H. Pendant le temps haut de l'horloge (PHASE N°1 de 0 à a T), le transistor T est commandé, la bobine L emmagasine de l'énergie et le condensateur C restitue son énergie à la charge. Pendant le temps bas de l'horloge (PHASE N°2 de a T à T), le transistor est bloqué et la bobine L restitue l'énergie emmagasinée, la diode est passante, le courant L diminue donc U_L change de signe et devient négative et par conséquence U_S.

Phase N°1 (0 à a T)

Explications: Le transistor est passant et la diode D est bloquée. Le condensateur restitue son énergie.

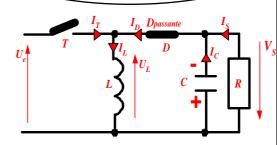


$$U_L = U_E \ avec U_S < U_E$$

Phase N°2 (a T à T)

Explications : Le transistor est bloqué et c'est la bobine qui fournit l'énergie au montage, la diode **D** est passante.

Schéma équivalent :



$$U_S = -U_L et U_L = L \frac{d I_L}{dt}$$

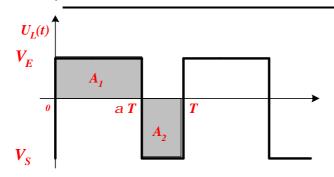
comme le courant ${\it I_L}$ diminue alors ${\it U_L} < 0$ en conséquence ${\it U_S} > {\it U_E}$





III.1.3.2) Calcul de la fonction de transfert :

$$U_S = f(U_E)$$



$$A_1 = U_E aT$$

$$A_2 = U_S (T - aT)$$

La valeur moyenne de la tension aux bornes d'une bobine est toujours nulle :

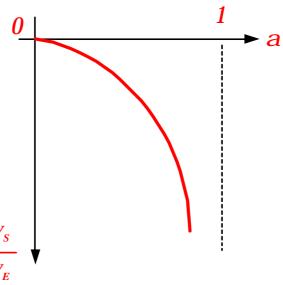
$$\langle \mathbf{U}_{L} \rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{L}(t) dt = \frac{1}{T} [A_{1} + A_{2}] = 0$$

$$\mathbf{U}_{E} \mathbf{a} + \mathbf{U}_{S} (1 - \mathbf{a}) = 0$$

$$\mathbf{a} \mathbf{U}_{E} + \mathbf{U}_{S} - \mathbf{a} \mathbf{U}_{S} = 0$$

Courbe de transfert.

$$\mathbf{U}_{\mathrm{S}} = -\frac{\mathbf{a}\,\mathbf{U}_{\mathrm{E}}}{(1-\mathbf{a})}$$



Les tensions élevées avec un rapport cyclique proche de 1 sont difficiles à atteindre à cause des imperfections des composants.



III.1.3.3) Etude des signaux

Phase N°1 (0 à a T)

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine augmente.

$$L\frac{di_{L}}{dt} = U_{E}$$

$$I_L(t) = \frac{\mathbf{U}_{\mathrm{E}}}{L}t + I_{\min}$$

2) ID : Courant dans la diode

La diode est bloquée : $I_D(t) = 0$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est passant : $I_T(t) = I_L(t)$

Phase N°2 (a T à T)

1) IL: Courant dans la bobine: Le courant dans la bobine diminue.

$$L \frac{di_L}{dt} = U_S$$

$$I_L(t) = \frac{U_S}{L}t + I_{\text{max}}$$

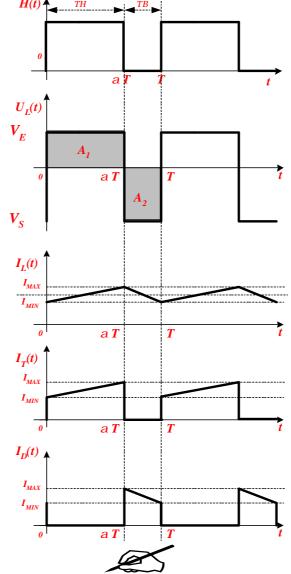
4) ID : Courant dans la diode

La diode est passante : $I_D(t) = I_L(t)$

3) IT : Courant dans le transistor

Le transistor est bloqué $I_T(t) = 0$

Les chronogrammes:





III.1.3.4) Choix des composants.

III.1.3.4.1) La bobine.

$$L = \frac{(1-a)|V_s|}{\Delta I_L F}$$

 $oldsymbol{F}$: Fréquence de travail du convertisseur.

DI_L Ondulation crête à crête du courant dans la bobine.

Critères technologiques .

Les selfs utilisées dans les alimentations à découpage doivent en autre supporter les hautes fréquences (jusqu'à 100KHz). Il faut toujours choisir les modèles préconisés par les constructeurs.

III.1.3.4.2) Le condensateur.

$$C = \frac{a I_S}{F \Delta V_S}$$

DV_S Ondulation crête à crête de la tension de sortie.

Critères technologiques :

Les condensateurs utilisés dans les alimentations à découpage doivent avoir une faible résistance série (ESR Effective Serie Resistor). En effet l'ondulation de la tension de sortie est proportionnelle aux variations de courant du condensateur.

III.1.3.4.3) Choix de la diode et du transistor T.

Le principal critère de choix de la diode doit être la rapidité, en effet les convertisseurs à découpage fonctionnent à des fréquences de l'ordre de la dizaine de kilohertz. On choisit par conséquent des diodes rapides comme les diodes *schottky*. Pour le transistor, il doit posséder une faible résistance et commuter rapidement, on utilise souvent des transistors *MOS*.

III.1.3.5) Performances.

Rendement: Si on considère des composants parfaits ($V_{SAT}=0V$ et $V_{seuil}=0V$) le rendement est de 100%, c'est-à-dire que l'on ne perd pas d'énergie!

En réalité la diode a une tension de seuil V_D et le transistor une tension V_{SAT} à ses bornes quand il conduit. On peut dans ces conditions calculer le rendement :

$$h = \frac{V_S (V_E - V_{sat})}{V_E (V_S + V_D)}$$

Avec cette équation on obtient des rendements de l'ordre de 80% à 90%, à comparer aux rendements des alimentations classiques de l'ordre de 50%.

Ondulations de sorties.



Ondulation du courant dans l'inductance :



$$\Delta I_L = \frac{a V_E}{LF}$$

Ondulation de la tension de sortie (ESR = 0W): [



$$\Delta V_{S} = \frac{I_{S} \mathbf{a}}{C F}$$





IV) Bibliographie.

- Alimentations à découpage Michel GIRARD DUNOD.
- ✓ Alimentations linéaires Michel GIRARD _ DUNOD.
- Les alimentations électroniques Pierre Mayé DUNOD.
- Les alimentations électroniques. R. DAMAYE
- Documents Techniques " constructeurs ".
- Mes cours " Electronique technique Industrielle du C.N.A.M "
- Internet.







Ce document est la propriété intellectuelle de son auteur.

ences de l'Ingénieur







<u>l'Electronique</u>!



Document de travail





<u>l'Electronique</u>!



Document de travail

